

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公開番号】特開2000-348493(P2000-348493A)

【公開日】平成12年12月15日(2000.12.15)

【出願番号】特願平11-156113

【国際特許分類第7版】

G 1 1 C 16/06

G 0 6 F 12/16

G 1 1 C 16/02

G 1 1 C 16/04

H 0 4 N 5/907

【F I】

G 1 1 C 17/00 6 3 4 E

G 0 6 F 12/16 3 4 0 S

H 0 4 N 5/907 B

G 1 1 C 17/00 6 1 2 E

G 1 1 C 17/00 6 2 1 A

G 1 1 C 17/00 6 4 1

【手続補正書】

【提出日】平成16年9月15日(2004.9.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

メモリセルの閾値電圧を変更することにより、第1及び第2の閾値電圧状態を第1及び第2のデータ値に対応させて情報を記憶するメモリ回路において、

第1の記録状態では、前記第1及び第2の閾値電圧が第1の基準電圧より低い又は高い状態にあり、第1の記録状態とは異なる第2の記録状態では、前記第1及び第2の閾値電圧が前記第1の基準電圧と異なる第2の基準電圧より低い又は高い状態にあり、

前記第1及び第2の記録状態に応じて、前記第1又は第2の基準電圧が設定され、

前記第1の記録状態では、前記第1及び第2の閾値電圧が、前記第2の基準電圧より低い又は高い電圧範囲にあり、前記第1の記録状態から前記第2の記録状態に遷移する時は、第1の記録状態にあった全てのセルトランジスタが、前記第2の基準電圧に対して消去状態になることを特徴とする不揮発性メモリ回路。

【請求項2】

請求項1において、

更に、第3．．．第N（Nは3以上の整数）の記録状態を有し、それぞれの記録状態で第3．．．第Nの基準電圧が設定され、

第M－1（Mは3以上の整数）の記録状態における第1及び第2の閾値電圧に対応する出力電圧が、第Mの基準電圧よりも高いまたは低いことを特徴とする不揮発性メモリ回路。

【請求項3】

請求項1において、

それぞれの記録状態において、セルトランジスタの閾値が更に第3．．．第N（Nは3

以上の整数)の閾値を有して、多値データを記録することを特徴とする不揮発性メモリ回路。